(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-54786

(43)公開日 平成11年(1999)2月26日

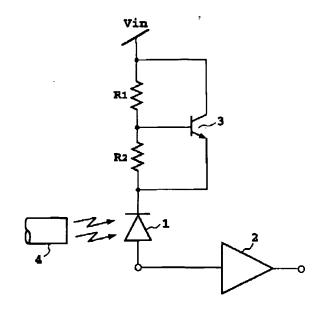
| (51) Int.Cl. ⁸ | | 識別記号 | ΡΙ | | | | | | | | |
|---------------------------|--------|------------------------|------|---|-----------|--------|-------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------|
| H01L | 31/107 | | | H0 | 1 L | 31/10 | | | В | | |
| | 31/10 | | | | | | | | G | ÷ | |
| H 0 4 B | 10/28 | | | H 0 | 4 B | 9/00 | | | Y | • | |
| | 10/26 | | | | | | | | | | |
| | 10/14 | | | | | | | | | | |
| | | | 審查請求 | 未請求 | 衣髓 | な項の数3 | OL | (全 | 4 頁 | () 最終 | 頁に続く |
| (21)出願番号 | | 特願平9-214251 | | (71) | 出願人 | | | | | | - |
| (00) (LIES II | | W-20 At (1007) 0 E 0 E | | | | | 建工 定 | | | | |
| (22)出願日 | | 平成9年(1997)8月8日 | | 576 HB | | | | 市中央区北浜四丁目5番33号 | | | |
| | | | | (12) | 発明者 | | | | ≠m &\ | mr a stalete | - Durboss |
| | | | | | | | | | | | 住友電 |
| | | | | (72) | 発明者 | | 全大共 企 | ·作工化 共 化 | 火 淡作 | ויאדעיו | |
| | | | | (12) | 76737 | | | i illi dili il | マ田公 | ₩T 1 512 l di | 住友電 |
| | | | | | | | 株式会 | | | | 江久电 |
| | | | | (74) | 代理力 | | t 谷 | | | | |
| | | | | \ | 1 4-2.7 | 71-323 | | • | V.F | О -ДЈ/ | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

(54) 【発明の名称】 光受信機

(57)【要約】

【課題】 アバランシェ・フォト・ダイオードを用いた 光受信機のダイナミックレンジを拡大すること。

【解決手段】 APD1に流れる光電流が小さく、抵抗R2の両端電圧がトランジスタ3のオン電圧より低い状態では、トランジスタ3のコレクタエミッタ間には電流が流れない。APD1に流れる光電流が増加し、抵抗R2の両端電圧がトランジスタ3のオン電圧よりも大きくなると、トランジスタ3が導通し、そのとき、コレクタエミッタ間電圧(Vce)は、Vce=Vbe×(R1+R2)/R2であり、この値に制限される。したがって、APD1に流れる光電流が増加してもトランジスタ3のコレクタエミッタを介して電流が流れ、APD1にはアバランシェ動作を確保できる電圧が印加された状態が確保される。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 バイアス電源と、アバランシェ・フォト ・ダイオードと、前記バイアス電源と前記アバランシェ ・フォト・ダイオードの一端とに接続された安定化抵抗 と、前記アバランシェ・フォト・ダイオードの他端に接 続された増幅手段とを有する光受信機において、前記安 定化抵抗に並列に電圧制限回路を設けたことを特徴とす る光受信機。

【請求項2】 請求項1において、

前記安定化抵抗は、直列接続された第1抵抗および第2 抵抗からなり、前記電圧制限回路は、前記アバランシェ ・フォト・ダイオードに光電流が流れて前記第1抵抗ま たは第2抵抗に生じた電圧降下によって導通して前記安 定化抵抗の両端をバイパスして前記アバランシェ・フォ ト・ダイオードに電流を供給するトランジスタからなる ことを特徴とする光受信機。

【請求項3】 バイアス電源と、アバランシェ・フォト ・ダイオードと、前記バイアス電源と前記アバランシェ ・フォト・ダイオードの一端とに接続された安定化抵抗 と、前記アバランシェ・フォト・ダイオードの他端に接 20 続された増幅手段とを有する光受信機において、前記安 定化抵抗と前記アバランシェ・フォト・ダイオードとの 接続部に前記バイアス電源とは別のバイアス電源の出力 を接続したことを特徴とする光受信機。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、アバランシェ・フ ォト・ダイオード (APD) を用いた光受信機に関す る。

[0002]

【従来の技術】APDを用いた光受信機において、アバ ランシェ動作がノイズなどの影響を受けないようにAP Dに直列に安定化抵抗を接続することが知られている。 [0003]

【発明が解決しようとする課題】上記安定化抵抗の値を 大きくすると、温度、電源電圧変動に対してAPDの動 作点が安定化され、受信感度の安定化に有利である。そ の一方、抵抗値が大きいと、光電流が大きくなったとき には、この安定化抵抗に流れる光電流による電圧降下量 が増大し、その結果、APDに適正な逆バイアス電圧が 40 印加されなくなり、APDのキャリア増倍係数も小さく なってしまう。すなわち、最大入力レベルが制限されて しまう。

【0004】そこで本発明の目的は、以上のような問題 を解消した光受信機を提供することにある。

[0005]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた め、請求項1にかかる発明は、バイアス電源と、アバラ ンシェ・フォト・ダイオードと、前記バイアス電源と前 れた安定化抵抗と、前記アバランシェ・フォト・ダイオ ードの他端に接続された増幅手段とを有する光受信機に おいて、前記安定化抵抗に並列に電圧制限回路を設けた ことを特徴とする。

【0006】また請求項2にかかる発明は、請求項1に おいて、前記安定化抵抗は、直列接続された第1抵抗お よび第2抵抗からなり、前記電圧制限回路は、前記アバ ランシェ・フォト・ダイオードに光電流が流れて前記第 1抵抗または第2抵抗に生じた電圧降下によって導通し 10 て前記安定化抵抗の両端をバイパスして前記アバランシ ェ・フォト・ダイオードに電流を供給するトランジスタ からなることを特徴とする。

【0007】さらに請求項3にかかる発明は、バイアス 電源と、アパランシェ・フォト・ダイオードと、前記バ イアス電源と前記アバランシェ・フォト・ダイオードの 一端とに接続された安定化抵抗と、前記アバランシェ・ フォト・ダイオードの他端に接続された増幅手段とを有 する光受信機において、前記安定化抵抗と前記アバラン シェ・フォト・ダイオードとの接続部に前記バイアス電 源とは別のバイアス電源の出力を接続したことを特徴と する。

[0008]

【発明の実施の形態】図1は本発明の第1の実施形態を 示す。

【0009】図1に示すように1はAPD、2は増幅器 であって、その入力端には、APD1のアノードを接続 する。APD1のカソードには、直列接続した2個の抵 抗R1およびR2を介してバイアス電源 (不図示) から の逆バイアス電圧Vinを印加する。3は電圧制限回路を 30 構成する n p n型のトランジスタであって、そのコレク タは抵抗R1のVin側、ベースは抵抗R1、R2の接続 部、エミッタは抵抗R2とAPD1のカソードとの接続 部に各々接続されている。

【0010】APD1に適切な逆バイアスが印加された 状態において、適当な手段(光ファイバー)4からの光 がAPD1に照射されると、アバランシェ動作によって APD1に光電流が流れ、その光電流を増幅器2が増幅 し、光受信出力として出力する。

【0011】ここで、電圧制限回路の動作を説明する。 【0012】APD1に流れる光電流が小さく、抵抗R 2の両端電圧(すなわちトランジスタ3のベースエミッ 夕間電圧(Vbe))がトランジスタ3のオン電圧より低 い状態では、トランジスタ3のコレクタエミッタ間には 電流が流れない。すなわち、APD1に流れる電流は抵 抗R1、R2を流れる電流と同じである。

【0013】APD1に流れる光電流が増加し、抵抗R 2の両端電圧がトランジスタ3のオン電圧よりも大きく なると、トランジスタ3が導通する。この時、APD1 に流れる電流は、抵抗R1、R2に流れる電流とトラン 記アバランシェ・フォト・ダイオードの一端とに接続さ 50 ジスタ3のコレクタエミッタ間を流れる電流との合計と

なる。トランジスタ3が導通状態のとき、抵抗R2の両 端電圧、すなわちトランジスタ3のVbeはトランジスタ 3のオン電圧(0.65~0.70V程度)と等しく、 抵抗R1 の両端電圧は抵抗R2との比に対応するから、 トランジスタ3のコレクタエミッタ間電圧(Vce)は、 Vce=Vbe×(R1+R2)/R2であり、この値に制 限される。この制限電圧はAPD1の動作を確保できる だけの値に設定する。したがって、APD1に流れる光 電流が増加してもトランジスタ3のコレクタエミッタを 介して電流が流れることになり、APD1にはアバラン シェ動作を確保できる電圧が印加された状態が確保され る。さらに、トランジスタ3の動作時のコレクタエミッ 夕間電圧 (Vce) はAPD1が必要最小限以上の電圧が 確保できるよう抵抗R1としては抵抗R2の値の比率を 設定し、その大きさ(抵抗値)は、どの程度の光電流を 閾値としてトランジスタ3を導通させるかに応じて決定 する。

【0014】図2は最大入力レベルについての比較実験結果を示す。本発明として図1の構成のものであって、抵抗R1として820KΩ、抵抗R2として150K 20Ω、トランジスタ3として2SC945、APD1としてゅ35μmのAPDを使用した。一方、比較のための従来例としてAPD1と同じAPDに1MΩの抵抗を直列に接続したもの(トランジスタは不使用)を使用し、APDのアノードを図1の増幅器2と同じ増幅器の入力端に接続した。そしてAPDに印加する逆バイアス電圧として68.0,70.0,72.0,および74.0 Vを用いて、622Mb/sの光信号をレベルを変えてAPDに照射してAPDの最大入力レベルを測定した。その結果を図2に示した。図2から本発明の方が大きな入 30カレベルが得られることが明らかである。

【0015】図3は本発明の第2の実施形態を示す。

【0016】図3に示すようにAPD1のカソードには 1個の安定化抵抗R3を介してバイアス電源(不図示) からの逆バイアス電圧Vinを印加する。5は上記不図示 のバイアス電源とは別のバイアス電源であって、その出 力をダイオード6を介してAPD1のカソードと抵抗R 3との接続部に供給する。ダイオード6はアノードをバ イアス電源5側に接続する。バイアス電源5の出力電圧 Vout は不図示のバイアス電源からの逆バイアス電圧V inより低く、かつAPD1のアバランシェ動作を確保で 10 きる電圧にする。

4

【0017】このような構成によれば、光電流が増加して安定化抵抗R3の電圧降下量が増加してもバイアス電源5からAPD1に電流が供給されるので、APD1に対してアバランシェ動作を確保することができる電圧を与えることができる。

[0018]

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、A PDを用いた光受信機のダイナミックレンジを拡大する ことができる。

20 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施形態にかかるブロック図である。

【図2】同実施形態における実験結果を示す図である。 【図3】本発明の第2の実施形態にかかるブロック図で

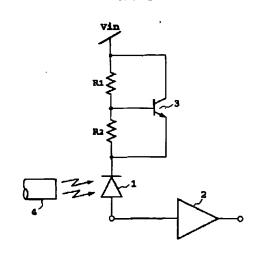
【符号の説明】

ある。

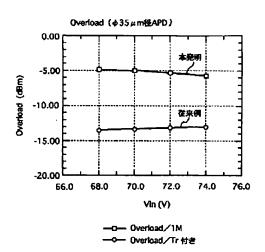
- 1 アバランシェ・フォト・ダイオード
- 2 増幅器
- 3 トランジスタ
-) 4 光ファイバー

R1, R2 抵抗

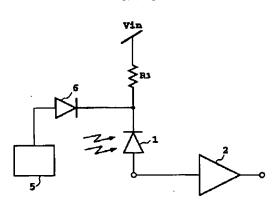
【図1】



【図2】







フロントページの続き

(51) Int. Cl. ⁶

識別記号

FΙ

H O 4 B 10/04 10/06